

ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Кремниевые диодные матрицы полупроводниковые

2ДС627А/ББ
2ДС627А/ББ «ОСМ»

АЕЯР.432120.515 ТУ, РД В 22.02.218 (для «ОСМ»)

Габаритный чертеж

Особенности

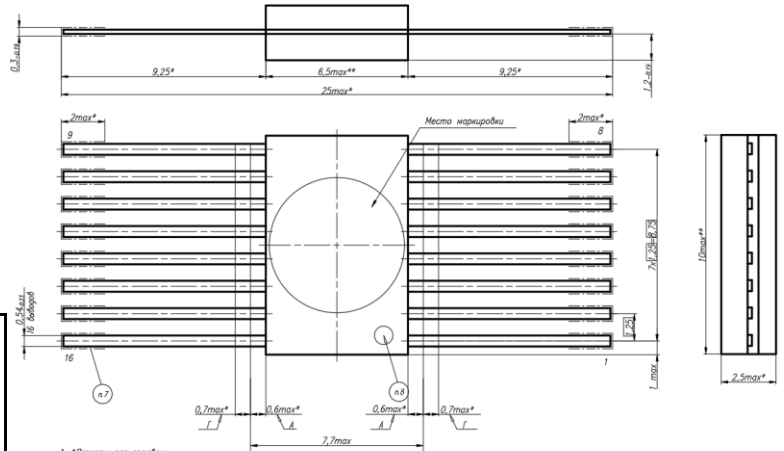
- керамикополимерный корпус 401.16-3
БЧО.487.005 ТУ.

Применение

- предназначены для работы в аппаратуре специального назначения.

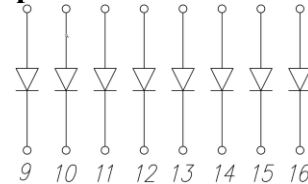
Предельно допустимые значения параметров

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма не более	Примечание
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В	U _{обр.макс}	50	1
Максимально допустимое повторяющееся импульсное обратное напряжение (при τ _и ≤ 2 мкс и Q ≥ 10), В	U _{обр.и.макс}	60	1, 2
Максимально допустимое неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В	U _{обр.и.нп}	70	1, 2
Суммарный максимально допустимый средний прямой ток через все диоды или любой одиночный диод, А - при температуре окружающей среды от минус 60 до 50°C - при температуре окружающей среды 125°C	I _{пр.ср.макс}	0,2 0,08	3
Максимально допустимый действующий прямой ток для каждого диода, А - при температуре окружающей среды от минус 60 до 50°C при температуре окружающей среды 125°C	I _{пр.д.макс}	0,2 0,08	3
Суммарный максимально допустимый импульсный прямой ток при длительности импульса не более 10 мкс без превышения I _{пр.ср.макс} через любое число диодов ДМП или любой одиночный диод, А - при температуре окружающей среды от минус 60 до 50°C - при температуре окружающей среды 125°C	I _{пр.и.макс}	1,5 0,75	3
Максимально допустимый ударный прямой ток для каждого диода, А (при температуре окружающей среды 25±10°C) (при τ _и ≤ 10 мкс и Q=50)	I _{пр.уд.макс}	2,5	4
Максимально допустимая температура перехода, °C	T _j	155	
Примечания 1 Для всего диапазона рабочих температур. 2 Длительность импульса определяется на уровне обратного напряжения 60 В. 3 Значения I _{пр.ср.макс} , I _{пр.д.макс} , I _{пр.и.макс} в диапазоне температур окружающей среды от 50 до 125 °C снижается линейно. 4 При температуре окружающей среды (25±10) °C.			



- 1 *Размеры для справок
- 2 А - фланец выбора не привязан для изготовления и монтажа
- 3 Толщина выбора в зоне А не регламентируется
- 4 Позиционный допуск плоскостности симметрии выбора в зоне Б 1/2 0,063 мм макс (отпуск задисциплины)
- 5 Нумерация выбора показана условно
- 6 Допускается: а) смещение крышки относительно оси основания в пределах габаритной основы б) расхождение клеи по выборам в пределах зоны А
- 7 Покрытие притой ПООУ 61-0,5 ГОСТ21931
- 8 Партии выбора обозначены углублением на крышке №0,8.

Принципиальная схема



Основные электрические параметры при T_{окр.среды} = (25±10)°C

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	Режим измерения
Постоянный обратный ток и его стабильность для каждого диода, мкА	I _{обр}	≤2	U _{обр} =50 В
Постоянное прямое напряжение для каждого диода, В	U _{пр}	≥0,85 ≤1,15	I _{пр} =200 мА
Время обратного восстановления ДМП каждого диода, нс	t _{вос}	≤40	I _{пр.и} =200 мА, U _{обр.и} =20 В, I _{обр.отсч} =10 мА, dI _{пр.и} /dt = 25А/мкс
Общая емкость каждого диода при нулевом смещении, пФ	C _д	≤5	
Импульсное прямое напряжение для каждого диода, В	U _{пр.и}	≤4	I _{пр.и} = 1 А, τ _и = 10 мкс, Q=500
Дифференциальное сопротивление каждого диода в открытом состоянии, Ом	r _д	≤10	I _{пр} = 100 мА
Тепловое сопротивление переход-среда каждого диода, °C/Вт	R _т	≤200	